

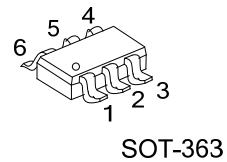
2N7002DW

Power MOSFET

300mA, 60V DUAL
N-CHANNEL POWER MOSFET

■ DESCRIPTION

The UTC **2N7002DW** uses advanced technology to provide excellent $R_{DS(ON)}$, low gate charge and operation with low gate voltages. This device is suitable for use as a load switch or in PWM applications.

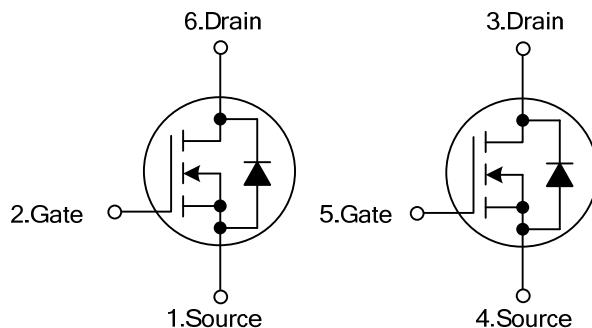


SOT-363

■ FEATURES

- * High Density Cell Design for Low $R_{DS(ON)}$.
- * Voltage Controlled Small Signal Switch
- * Rugged and Reliable
- * High Saturation Current Capability

■ SYMBOL

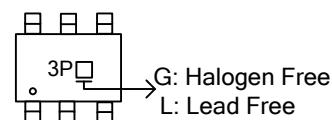


■ ORDERING INFORMATION

Ordering Number		Package	Pin Assignment						Packing
Lead Free	Halogen Free		1	2	3	4	5	6	
2N7002DWL-AL6-R	2N7002DWG-AL6-R	SOT-363	S1	G1	D2	S2	G2	D1	Tape Reel

2N7002DWG-AL6-R	(1)Packing Type (2)Package Type (3)Halogen Free	(1) R: Tape Reel (2) AL6: SOT-363 (3) G: Halogen Free, L: Lead Free
-----------------	---	---

■ MARKING



■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_A=25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted.)

PARAMETER		SYMBOL	RATINGS	UNIT
Drain-Source Voltage		V_{DSS}	60	V
Drain-Gate Voltage ($R_{GS} \leq 1\text{M}\Omega$)		V_{DGR}	60	V
Gate Source Voltage	Continuous	V_{GSS}	± 20	V
	Non Repetitive($t_p < 50\mu\text{s}$)		± 40	
Drain Current	Continuous	I_D	300	mA
	Pulsed		800	
Power Dissipation		P_D	200	mW
Derated Above 25°C			1.6	$\text{mW}/^\circ\text{C}$
Junction Temperature		T_J	+ 150	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature		T_{STG}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

Note: Absolute maximum ratings are those values beyond which the device could be permanently damaged.

Absolute maximum ratings are stress ratings only and functional device operation is not implied.

■ THERMAL DATA

PARAMETER		SYMBOL	RATINGS	UNIT
Junction to Ambient		θ_{JA}	625 (Note1)	$^\circ\text{C}/\text{W}$

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A=25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
OFF CHARACTERISTICS						
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	$V_{GS}=0\text{V}, I_D=10\mu\text{A}$	60			V
Drain-Source Leakage Current	I_{DSS}	$V_{DS}=60\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$			1	μA
Gate-Source Leakage Current	I_{GSSF}	$V_{GS}=20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$			100	nA
	I_{GSSR}	$V_{GS}=-20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$			-100	nA
ON CHARACTERISTICS (Note 2)						
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(TH)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu\text{A}$	1	2.1	2.5	V
Drain-Source On-Voltage	V_{DS} (ON)	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=300\text{mA}$		0.6	3.75	V
		$V_{GS}=5.0\text{V}, I_D=50\text{mA}$		0.09	1.5	
Static Drain-Source On-Resistance	R_{DS} (ON)	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=300\text{mA}, T_J=125^\circ\text{C}$			13.5	Ω
		$V_{GS}=5.0\text{V}, I_D=50\text{mA}$			7.5	Ω
DYNAMIC CHARACTERISTICS						
Input Capacitance	C_{ISS}	$V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$		20	50	pF
Output Capacitance	C_{OSS}			11	25	pF
Reverse Transfer Capacitance	C_{RSS}		4	5		pF
Turn-On Time	t_{ON}	$V_{DD}=30\text{V}, R_L=150\Omega$ $I_D=200\text{mA}, V_{GS}=10\text{V}$ $R_{GEN}=25\Omega$			20	nS
Turn-Off Time	t_{OFF}	$V_{DD}=30\text{V}, R_L=25\Omega$ $I_D=200\text{mA}, V_{GS}=10\text{V}$ $R_{GEN}=25\Omega$			20	nS
DRAIN-SOURCE DIODE CHARACTERISTICS AND MAXIMUM RATINGS						
Drain-Source Diode Forward Voltage	V_{SD}	$V_{GS}=0\text{V}, I_S=300\text{mA}$ (Note)		0.88	1.5	V
Maximum Pulsed Drain-Source Diode Forward Current	I_{SM}				0.8	A
Maximum Continuous Drain-Source Diode Forward Current	I_S				300	mA

Note: 1. Device mounted on FR-4 PCB, 1 inch x 0.85 inch x 0.062 inch. Minimum land pad size.

2. Pulse Test: Pulse Width≤300μs, Duty Cycle≤2.0%

■ TEST CIRCUIT AND WAVEFORM

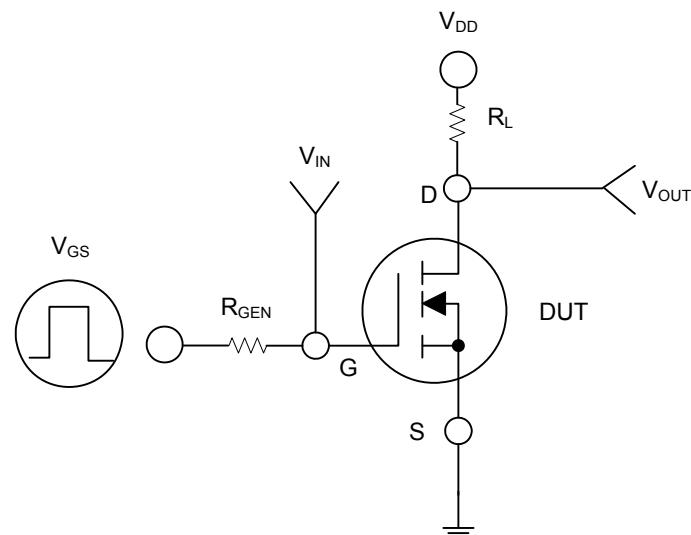


Fig. 1

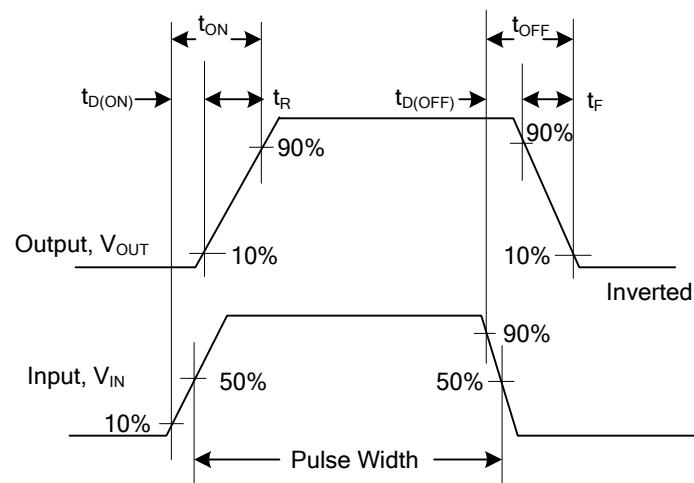
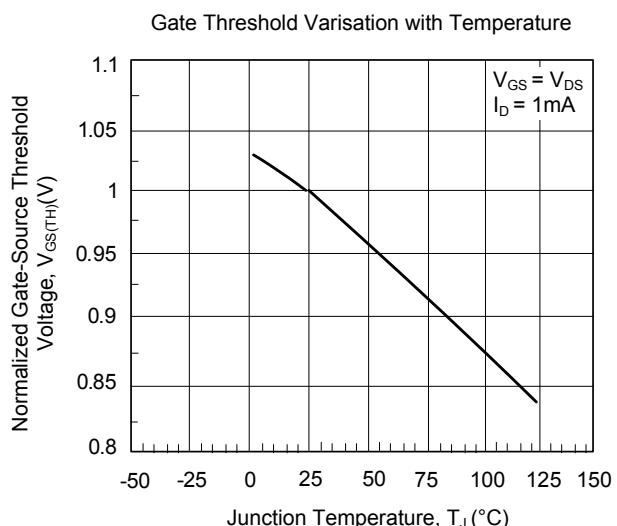
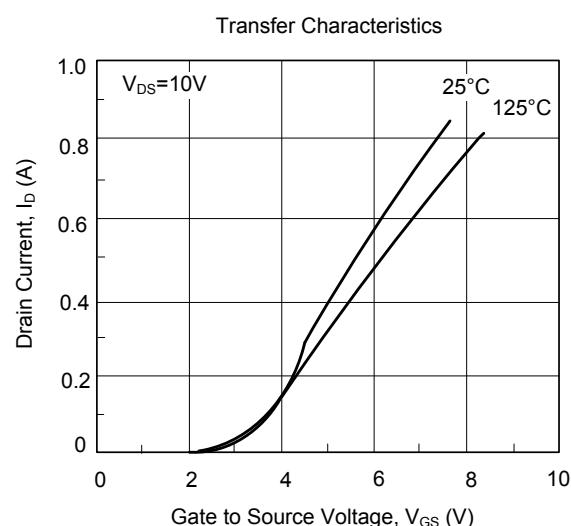
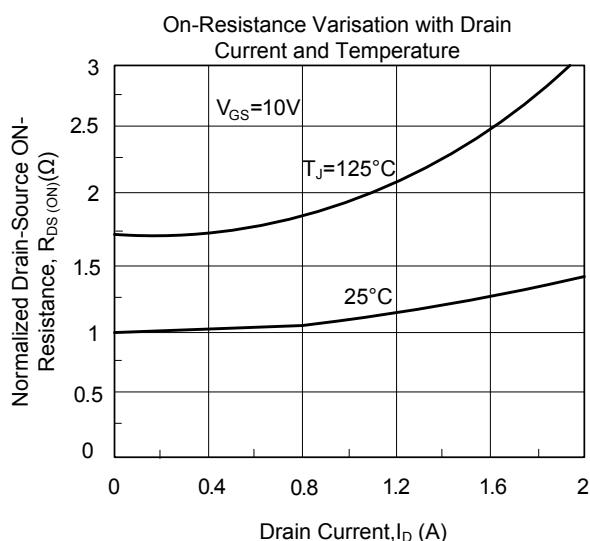
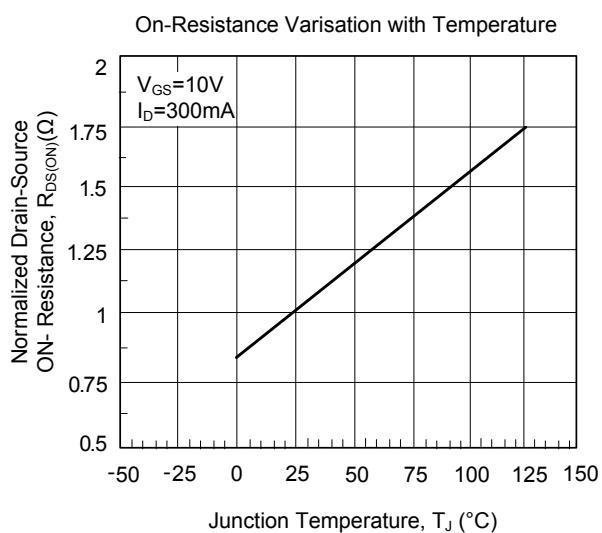
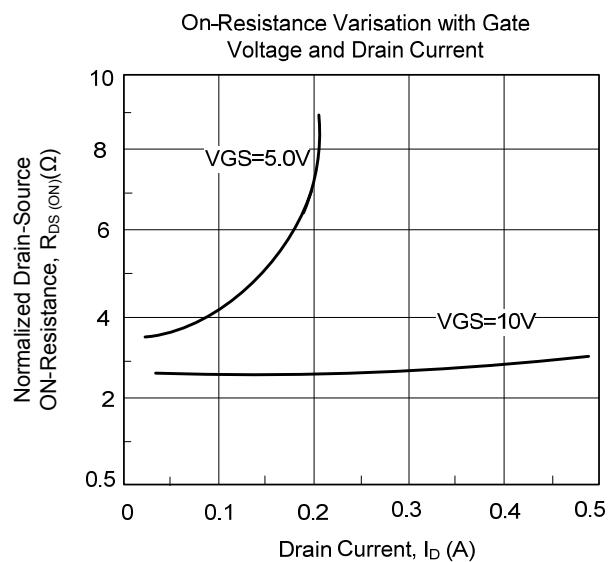
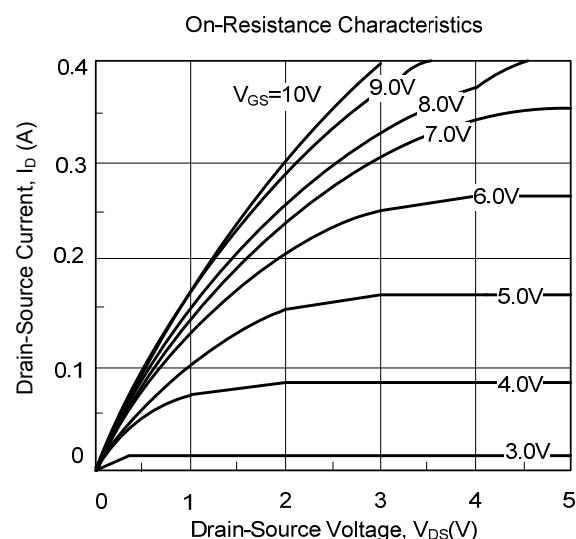
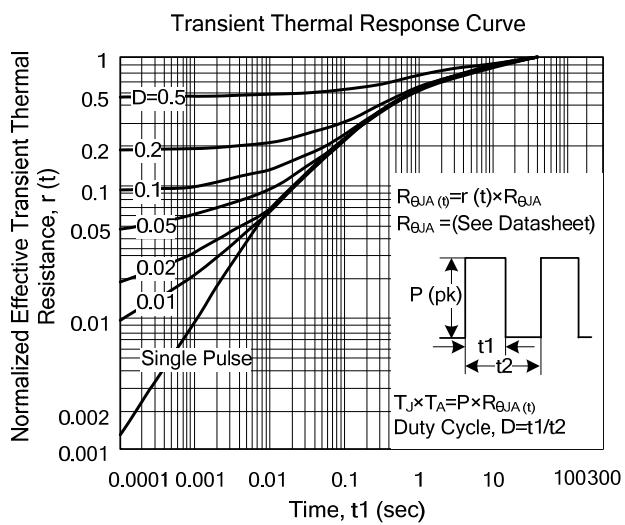
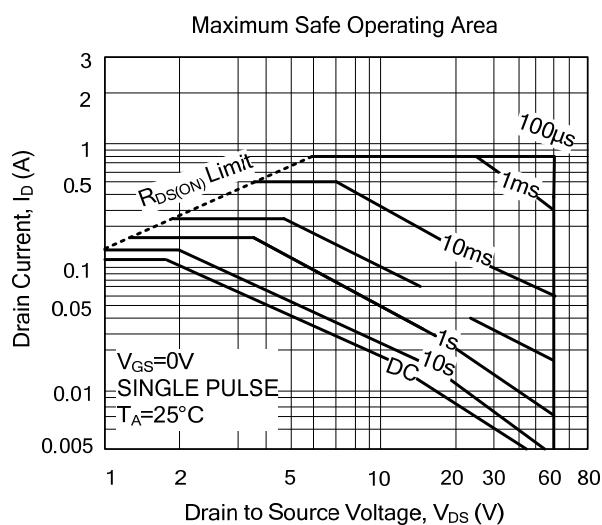
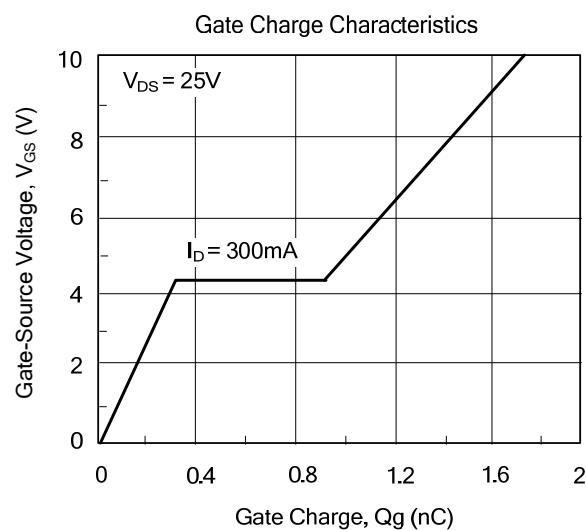
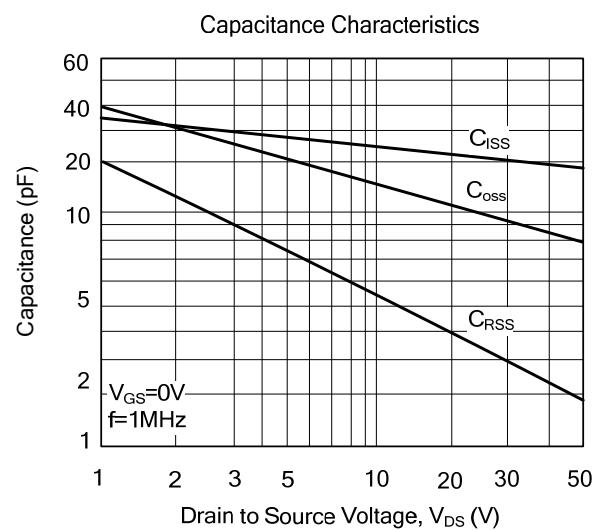
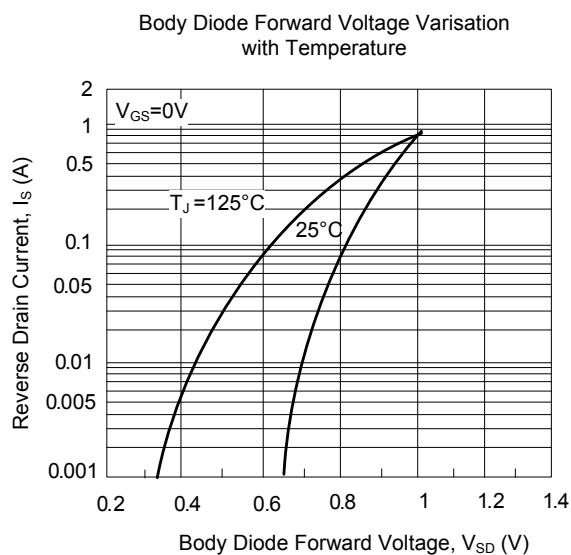
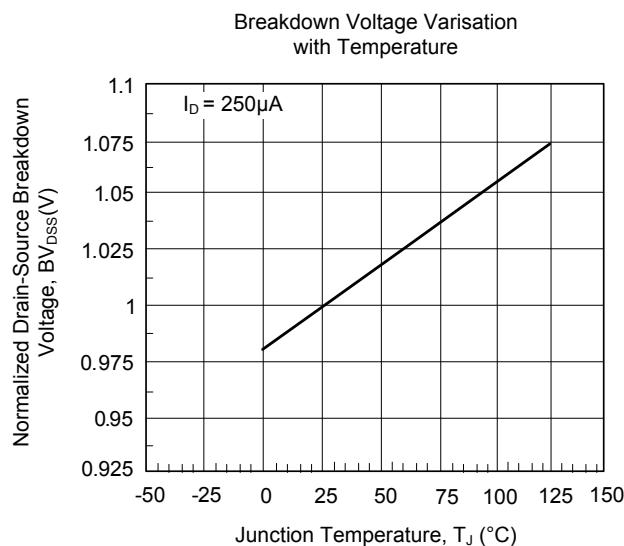


Fig. 2 Switching Waveforms

■ TYPICAL CHARACTERISTICS



■ TYPICAL CHARACTERISTICS (Cont.)



UTC assumes no responsibility for equipment failures that result from using products at values that exceed, even momentarily, rated values (such as maximum ratings, operating condition ranges, or other parameters) listed in products specifications of any and all UTC products described or contained herein. UTC products are not designed for use in life support appliances, devices or systems where malfunction of these products can be reasonably expected to result in personal injury. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.





гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок

AMD

ANALOG DEVICES

BOURNS

Coilcraft
The world's largest manufacturer of magnetic components

élan tec
Semiconductor, Inc.

HARRIS

infineon

JRC

MICREL
Innovation through Technology™

MOTOROLA

nichicon

PHILIPS

ROHM

ST SGS-THOMSON
Microelectronics

Sipex

TAIYO YUDEN

TOKO

ZILAS

Winbond
Electronics Corp.

Allegro
MicroSystems, Inc.

ATMEL

BURR - BROWN
BB

EXAR

HITACHI
Inspire the Next

intel

Lattice
Semiconductor Corporation

muRata
Leader in Electronics

OKI

QUALCOMM

SAMSUNG

SHARP

SONY

TDK

TOSHIBA

XORX

ALTERA

AVX
Components

CATALYST

CYPRESS
TECHNOLOGY

FAIRCHILD
SEMICONDUCTOR

HOLTEK

International IOR Rectifier

LINEAR TECHNOLOGY
mitsubishi

National Semiconductor

ON Semiconductor
UN

REALTEK
Radish Semiconductor Corp.

SANYO

SHINDENGEN

SS

TECCOR
ELECTRONICS

TUNDRA

XILINX

Amphenol

Bay Linear

CIRRUS LOGIC

DALLAS

FUJITSU

IDT

intersil

MAXIM

molex

NEC

Panasonic

RENESAS

SII
Silico Instruments Inc.

SIEMENS

ST

TEXAS INSTRUMENTS

VISHAY

ZETEX
SEMICONDUCTORS



гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>